

第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源草案

總說明

一百零四年七月一日總統令公布溫室氣體減量及管理法（以下簡稱溫管法），為掌握二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫及三氟化氮等溫室氣體排放情形，爰參採國際上對溫室氣體管理作法及一百零二年開始依空氣污染防制法管制經驗，列管主要來自於製程或設施直接排放之溫室氣體排放源，擬具本公告促使我國主要溫室氣體排放源執行溫室氣體排放量盤查登錄作業。

第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源草案

公告	說明
主旨：公告第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源，並自即日生效。	公告名稱。
依據：溫室氣體減量及管理法第十六條第一項。	法源依據。
公告事項： 第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源，如附表。	<p>一、適用對象。</p> <p>二、本公告納管對象係整合依空氣污染防治法公告兩批次「公私場所應申報溫室氣體排放量之固定污染源」，其依一百零三年申報資料統計，計列管二百六十五家，預估可掌握百分之八十以上我國工業及能源部門化石燃料燃燒產生溫室氣體之排放量。</p> <p>三、第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源，以能源密集及主要耗能產業等大規模排放源為主，包含電力、鋼鐵、水泥、半導體、薄膜電晶體液晶顯示器、石油煉製等行業；另參採國際作法以化石燃料燃燒產生溫室氣體年排放量達二·五萬公噸二氧化碳當量以上為門檻，納管行業別含石油化工原料製造、人造纖維製造、紙漿、紙及紙製品製造等行業及其他排放源。</p>

附表：第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源草案

批次	溫室氣體排放源		條件說明	計算說明
	行業別	製程別		
第一批	發電業	汽力機組鍋爐發電程序	指具備汽力機組鍋爐發電程序且採用化石燃料者。	一、溫室氣體排放源具有左列任一製程或設備者，應依規定進行全廠(場)溫室氣體年排放量盤查及登錄。 二、溫室氣體排放源應依下列計算方式，判定全廠(場)化石燃料燃燒產生溫室氣體年排放量是否達一定門檻： $\text{溫室氣體年排放量(公噸二氧化碳當量/年)} = \text{當年原料、燃料使用量、產品產量或其他經主管機關認定之操作量(公噸、公秉)}$
		複循環機組發電程序	指具備複循環機組發電程序且採用化石燃料者。	
	鋼鐵業	一貫煉鋼鋼胚生產程序	指包含煉鐵、煉鋼、熱軋、冷軋等程序，且生產鋼胚者。	
		電弧爐碳鋼鋼胚生產程序	指包含電弧爐煉鋼程序、精煉爐及連續鑄造程序，且生產碳鋼鋼胚者。	
		電弧爐不銹鋼鋼胚生產程序	指包含電弧爐煉鋼程序、轉爐、真空精煉爐及連續鑄造程序，且生產不銹鋼鋼胚者。	
		H型鋼生產程序	指包含加熱、軋製、噴砂及研磨程序，且生產H型鋼者。	
		不銹鋼熱軋鋼捲(板)生產程序	指包括含加熱及軋製軋鋼程序，且生產不銹鋼熱軋鋼捲(板)者。	
	石油煉製業	石油煉製程序	以礦產原油或油頁岩等為原料，從事汽油、煤油、柴油、潤滑油、石蠟、石油醚、有機溶劑或其他石油品之提煉者。	
	水泥業	具備熟料生產程序	熟料生產程序包含生料研磨製程及熟料燒成製程。其中熟料係指含氧化鈣(CaO)、氧化矽(SiO ₂)、氧化鋁(Al ₂ O ₃)及氧化鐵(Fe ₂ O ₃)之原料，依適當比例並經研磨後投入於水泥窯爐中，燒至部分熔融所得以矽酸鈣為主要礦物成分之水硬性膠凝物質。	
	半導體業	積體電路晶圓製造程序	指包括經由物理氣相沈積、化學氣相沈積、光阻、微影、蝕刻、擴散、離子植入、氧化與熱處理	

			等製程；僅從事晶圓封裝、磊晶、光罩製造、導線架製造、二極體製造及發光二極體製造等作業者或製程中確實未使用含氟溫室氣體者，非屬本公告之適用對象。	或千立方公尺/年)×排放係數(公噸/公噸、公秉/公噸或千立方公尺/公噸)×溫暖化潛勢前項原(物)料、燃料使用量、產品產量或其他經主管機關認定之操作量，應依據前一年度實際活動數據計算之。但公告後始設立之溫室氣體排放源，其活動數據應採用最大設計值。
	薄膜電晶體液晶顯示器業	具備薄膜電晶體元件陣列基板或彩色濾光片生產程序	指薄膜電晶體液晶顯示器製造過程中，包括擴散、薄膜、黃光顯影、蝕刻或彩色濾光片等程序；製程中確實使用含氟溫室氣體，屬本公告之適用對象。	
	各行業	其他設備	全廠(場)化石燃料燃燒之直接排放產生溫室氣體年排放量達二·五萬公噸二氧化碳當量。	